

Optics and Spectroscopy 72, 5 (1992) 579-580

Role of vacancy defects in luminescence CsI

A.V. Gektin, N.V. Shiran, V.Ya. Serebryanyi, A.M. Kudin, T.A. Charkina

Institute for Single Crystals, NASU, Kharkov, Ukraine

The peculiarities of the luminescence of CsI deformed crystals are studied. It is shown that vacancy centers play the most important role in the enhancement of luminescence in 430-530 nm region.

Role of vacancy defects in luminescence CsI

A.V. Gektin, N.V. Shiran, V.Ya. Serebryanyi, A.M. Kudin, T.A. Charkina

Optics & Spectroscopy. 1992. Vol. 72, 5. P. 579-580.

WOS:A1992JX99900002

Роль вакансионных дефектов в люминесценции CsI

А.В. Гектин, Н.В. Ширан, В.Я. Серебряный, А.М. Кудин, Т.А. Чаркина

Институт монокристаллов АН Украины, Харьков

Исследованы особенности люминесценции деформированных кристаллов CsI. Показано, что главную роль в усилении свечения в области 430-530 нм играют вакансионные центры, причем их структура и особенности локализации электронных возбуждений определяют спектральные характеристики люминесценции

Оптика и спектроскопия, том 72, вып. 5 (1992) с. 1061-1063